







DOI: 10.22044/JSFM.2022.11331.3491

مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی نیروی مسدود عملگر ترفنل-دی

سهیل طالبیان^(*) ^۱استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

مقاله مستقل، تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳؛ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

چکیدہ

ترفنل-دی به دلیل توانایی اعمال نیروهای بزرگ در دامنه فرکانسی وسیع، کاربرد بسیاری در عملگرهای دگررسان مغناطیسی دارد. وابستگی ضرایب ساختاری ماده به میدان مغناطیسی و افت انرژی مغناطیسی، پیش بینی نیروی خروجی عملگر را پیچیده می سازد. در این مقاله، یک مدل تجربی-تئوری جهت پیش بینی نیروی مسدود عملگر ترفنل-دی در شرایط مختلف کاری پیشنهاد شده است. در ابتدا یک مدل خطی در میدان مغناطیسی مستقیم و سپس یک مدل بهبودیافته با معرفی ضریب بازده انرژی در میدان مغناطیسی متناوب ارائه شده است. ضریب مذکور با استفاده از روابط تجربی مربوط به توانهای اتلافی پسماند، جریانهای گردابهای و اضافی به دست آمده است. به منظور استخراج ضرایب عملکردی در مدل پیشنهادی، رفتار تنش-کرنش ترفنل دی با استفاده از یک مجموعه آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته و یک رابطه تجربی جهت پیش بینی این ضرایب در مقادیر مختلف میدان مغناطیسی به دست آورده شده است. مدل پیشنهادی شامل روابط توانی از دو کمیت شدت و فرکانس جریان الکتریکی عملگر است که محاسبه نیروی مسدود آن را در بازه فرکانسی میده هرتز مقدور می سازد. نتایج مدل سازی با نتایج تجربی مورد مقایس قرار گرفته و خطاهای کم مشاهده شده، صحت مدل را نشان می همی روابط توانی از دو کمیت شدت و فرکانس جریان الکتریکی عملگر است که محاسبه نیروی مسدود آن را در بازه فرکانسی هرتز مقدور می سازد. نتایج مدل سازی با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته و خطاهای کم مشاهده شده، صحت مدل را نشان میدهد. گردابهای، توان اتلافی اضافی

Experimental Study and Modelling of the Blocked Force of Terfenol-D Actuator

Soheil Talebian^{1*}

¹Assictance Professor, Mechanical Engineering Department, Razi University, Kermanshah, Iran

Abstract

Terfenol-D is widely used in magnetostrictive actuators due to capability of applying mechanical forces in large values of magnitude and frequency. Dependency of structural coefficients of Terfenol-D on magnetic field intensity and losses of magnetic energy make it complicated to predict the value of actuator's output force. In this paper, an experimental-theoretical model is presented to predict blocked force of the actuator at different operational conditions. Initially, a linear model for DC magnetic filed and an improved model introducing an energy efficiency coefficient for AC magnetic filed are proposed. The energy efficiency coefficient is obtained based on experimental power relations for hysteresis, eddy currents and excess power losses. An experimental setup is used to obtain stress-strain behavior of the actuator to extract the structural coefficients of the proposed model and an experimental relation is governed to predict the coefficients at different values of magnetic field. The proposed model contains power relations of amplitude and frequency of electrical current passing through the actuator which makes it possible to calculate blocked force at frequency range of 0-400 Hz. Obtained results of the model are validated by comparing to experimental results and the small values of errors show the model's precision.

Keywords: magnetostriction, Terfenol-D actuator, blocked force of actuator, hysteresis power loss, eddy currents power loss, excess power loss

* نویسنده مسئول؛ تلفن: ۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۳ فکس: ۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۳

آدرس پست الكترونيك: s.talebian@razi.ac.ir

۱– مقدمه

به تغییر شکل ماده فرومغناطیس در اثر مغناطیس شدگی آن که عمدتا بر اثر اعمال میدان مغناطیسی خارجی صورت می گیرد، دگررسانی مغناطیسی می گویند. این پدیده مرتبط با اثرات فیزیکی مختلفی است که از بین این اثرات، اثر ژول ً از همه پرکاربردتر است [۱]. اثر ژول، تغییر طول ماده دگررسان مغناطیسی در پاسخ به میدان مغناطیسی خارجی است و نتیجه آن، یک کرنش الاستیک است که در ساخت انواع عملگرها کاربرد دارد. ترفنل-دی آلیاژ آهن، تریبیوم و دسپرسيوم ميباشد و نام آن از اول نام اين عناصر و آزمایشگاه سازنده آن (ناوال اوردنانس)، گرفته شدهاست. هر سه عنصر پایه این آلیاژ، فرومغناطیس هستند و درصد آنها در آلیاژ متفاوت است. یک مورد متداول آن Tb0.3D0.7Fe1.9 است [۲]. ترفنل-دی، به دلیل ویژگیهایی همچون توانایی تغییر طول و اعمال نیروی زیاد (در مقایسه با سایر مواد هوشمند)، دمای کوری بالا،⁶ ضریب جفت شدگی² بزرگ و نیز قابلیت استفاده در دامنه فرکانسی وسیع، کاربرد بسیاری در ساخت انواع عملگرها دارد. از این عملگرها در کنترل فعال ارتعاشات [۳]، شیرهای مغناطیسی [۴]، سوختیاشها [۵] و غيره استفاده مي شود.

عملگرهایی که از ترفنل-دی استفاده می کنند، به دو دسته نیمه ایستا و دینامیک تقسیم بندی می شوند. از عملگرهای نیمه ایستا در فرکانس های پایین و متوسط (کمتر از ۲ کیلوهرتز) و به عنوان منبع اعمال نیرو یا جابجایی کنترل شده، استفاده می شود. به منظور مدل سازی رفتار این عملگرها از مدل های خطی یا غیر خطی مکانیکی -مغناطیسی استفاده می شود [۶]. عملگرهای دینامیک در فرکانس های تشدید کار می کنند و دارای کرنش دینامیکی بالایی هستند و استفاده اصلی آن ها در عملگرهای توان بالاست. مدل سازی آنها عمدتا شامل حل معادلات مربوط به انتشار موج است [۲]. در عملگرهای ترفنل -دی^۲از دو مفهوم برای بررسی

خروجی یا بازده عملگر استفاده میشود. مفهوم اول نیرو یا تنش مسدود است که به بیشترین نیروی قابل حصول از ماده دگررسان مغناطیسی اطلاق میشود. نیرو یا تنش مسدود در حالتی رخ میدهد که ماده در حالت کاملا محصور قرار گرفته باشد، به نحوی که امکان افزایش طول نداشته باشد. مفهوم دوم جابجایی آزاد یا کرنش اشباع است و عبارت از افزایش طول ماده بدون هیچ محدودیتی است [۸].

مدلسازی و پیشبینی نیروی مسدود عملگرهای ترفنل-دی با محدودیتهایی همراه است. مهم ترین عامل محدودکننده در فرکانسهای کمتر از ۱۰ هرتز (که رفتار ماده مستقل از فركانس ميدان مغناطيسي است) [٩]، وابستگي ضرايب مكانيكي-مغناطيسي ماده به شدت ميدان مغناطيسي و پیشتنش مکانیکی است. مطالعات انجام شده، نشان میدهد که ضرایب دگررسانی مغناطیسی، انطباق الاستیکی و تراوایی مغناطیسی ترفنل-دی، مقادیر ثابتی ندارند و تابع شدت میدان مغناطیسی و پیشتنش مکانیکی اعمالی هستند. ضریب دگررسانی مغناطیسی^معیاری است که میتوان با آن در مورد کارایی ماده قضاوت کرد و بیانگر ارتباط بین کرنش خروجی با شدت میدان مغناطیسی اعمالی است. همچنین ضريب انطباق الاستيكى ميزان نرمى يا سختى ترفنل-دى را در هنگام اعمال تنشهای مکانیکی نشان میدهد و تراوایی مغناطیسی نیز بیانگر توانایی عبوردهی مغناطیسی در ماده است که در دو حالت آزاد و محصور اندازه گیری می *شود.* سان و همكاران، مدلى براى رفتار ترفنل-دى و على الخصوص پیشبینی کرنش آزاد آن در مقادیر مختلف پیشتنش مکانیکی و میدان مغناطیسی اولیه ^۹ پیشنهاد دادهاند که در این مدلسازی تنها از ضریب دگررسانی مغناطیسی استفاده شده و سایر ضرایب در نظر گرفته نشدهاند [۱۰]. فلاتو و همکاران با انجام آزمایشهای تجربی، به بررسی آماری ضرایب ساختاری ترفنل-دی در ۵۰ نمونه با ترکیبات شيميايى متفاوت پرداختهاند. اين مطالعه ماهيت تجربى-آماری داشته و به ارائه مدلی جهت پیشبینی ضرایب مذکور در مقادیر مختلف شدت میدان مغناطیسی نمی پردازد [۱۱]. ژانگ و همکاران، یک مدل غیرخطی مبتنی بر معادلات جفت

8 Magnetostriction Coefficient

9 Bias magnetic field

¹ Magnetostriction

² Julle Effect ³ Terfenol-D

⁴ Naval Ordnance

⁵ Currie Temperature

⁶ Coupling Factor

⁷ Magnetostrictive Actuators

فرکانسهای پایین مورد بررسی قرار دادهاند و به این نتیجه رسیدهاند که با افزایش پیشتنش مکانیکی، افت توان ناشی از يسماند مغناطيسي كاهش مييابد [١۴]. اين تحقيق صرفا جنبه تجربى داشته و مدلى براى تخمين مقدار توان افت شده پیشنهاد نشدهاست. جیانبین و همکارانش افت توان ناشی از پسماند را در یک عملگر ترفنل-دی مطالعه نمودهاند و با استفاده از مدل جایلز-اترتون و روش حل اجزا محدود، مقدار افت توان را به دست آوردهاند. از آنجا که ورودی مدل جایلز-اترتون، دادههای کامل مربوط به هر چرخه مغناطیسی است، استفاده از این مدل در فرکانس های بالاتر منوط به در دست داشتن این دادهها در آن فرکانس است [10]. هوآنگ و همکاران نیز انواع افتهای توان در ترفنل-دی (پسماند و جریان گردابهای) را به صورت تجربی مورد مطالعه قرار دادهاند و در نهایت با استفاده از برازش خطی بر روی نتایج تجربی، مدل تجربی خود را ارائه دادهاند [۱۶]. در مدل مربوطه اثرات پیشتنش مکانیکی مورد بررسی قرار نگرفتهاست. طالبیان و همکاران افت توان ناشی از پسماند در ترفنل-دی را به صورت تجربی در مقادیر مختلف فرکانس و شدت میدان مغناطیسی مطالعه کردهاند و روابط تجربی شامل عبارات توانی از کمیتهای موثر بر اتلاف توان را ارائه دادهاند [۱۷].

هنگامی که ترفنل-دی در معرض میدان مغناطیسی متغیر با زمان قرار می گیرد، در آن جریان های گردابه ای ایجاد می شود. جریان های گردابه ای با ایجاد یک میدان مغناطیسی در جهت مخالف با میدان تحریک، مانع عبور شار مغناطیسی شوند. جریان های گردابه ای باعث افت توان به صورت گرما می شوند که عامل مهمی در کاهش بازده عملگرهای دگررسان مغناطیسی خصوصا در فرکانسهای بالا است. روش تجربی برای اندازه گیری اتلاف توان ناشی از جریانهای گردابهای وجود ندارد و بدین منظور از معادلات الكترومغناطيس استفاده مى شود [١٨]. صرف نظر از روش به دست آوردن معادلات حاکم، فرضیاتی همچون همگن بودن ضریب تراوایی مغناطیسی، بسته شدن شار مغناطیسی در مسیرهای دایروی و یکنواخت بودن خطوط میدان داخل ماده، در تمامی روشها وجود داشتهاند [۱۹]. در بیشتر مطالعات انجامشده در عملگرهای دگررسان مغناطیسی، اثر جریانهای گردابهای با افزودن یک مقاومت معادل به مدار

شده مکانیکی-مغناطیسی جهت پیشبینی منحنیهای پسماند مکانیکی و مغناطیسی ماده در شرایط کاری مختلف پیشنهاد دادهاند. آنها یک رابطه تحلیلی برای تراوایی مغناطیسی ماده به دست آورده و به صورت تجربی مورد صحت سنجی قرار دادهاند، اگر چه راجع به ضرایب دیگر ماده تحلیلی انجام نشدهاست [۱۲]. دامنجود و همکاران یک مجموعه آزمایشگاهی ابتکاری جهت بررسی خواص ترفنل-دی تحت پیشتنش مکانیکی ساخته و کرنش خروجی ماده را به دست آوردهاند. آزمایشها به گونهای طراحی شدهاند که مقادیر تنش و میدان مغناطیسی در حین آزمایش تغییر نکند. در این پژوهش، مدلی جهت تبیین رفتار ماده و وابستگی کمیتهایهای خروجی به کمیتهای ورودی ارائه نشدهاست [۱۳]. با این که در تحقیقات فوق به وابستگی خصوصیات ذاتی ترفنل-دی (از قبیل ضریب دگررسان مغناطیسی و ضریب انطباق الاستیکی) به مقادیر تنش و شدت میدان مغناطیسی اشاره شدهاست، اما این تحقیقات صرفا جنبه کیفی داشته و به چگونگی این تغییرات، کمیسازی و ارائه مدلی جهت پیشبینی مقدار این ضرایب اشاره نشدهاست.

در فرکانسهای بالاتر از ۱۰ هرتز که رفتار مغناطیسی ماده وابسته به فرکانس است، مهمترین عامل موثر بر مدلسازی رفتار عملگر، افتهای ایجاد شده در انرژی مغناطیسی منتقل شده به ترفنل-دی است. افت توان پسماند، توان اتلافی جریان گردابه ای⁷و توان اتلافی اضافی⁷ دانست. ترفنل-دی همانند همه مواد فرومغناطیس دارای پسماند مغناطیسی است که به علت حرکت و چرخش مغناطیس شوندگی رخ میدهد. با افزایش فرکانس میدان مغناطیسی خارجی، افت ناشی از پسماند مغناطیسی به علت کم شدن زمان هر چرخه و نیز عریض تر شدن چرخه پسماند افزایش مییابد. یاماموتو و همکارانش تاثیر پیش تنش مکانیکی بر افت توان ناشی از پسماند ترفنل-دی را در

¹Hysteresis

² Hysteresis power loss

³ Eddy currents power loss

⁴ Excess power loss

الکترومکانیکی عملگر لحاظ شدهاست که تنها می تواند تخمینی از اتلاف توان را به دست دهد [۲۰]. طالبیان و همکاران با حل همزمان معادلات ماکسول، میدان الکتریکی داخلی ترفنل-دی را به دست آورده و توان اتلافی ناشی از جریانهای گردابهای را محاسبه کردهاند. آنها از دادههای تجربی به عنوان ورودی مدل استفاده کرده و در نهایت روابط تجربی شامل عبارات توانی از فرکانس و پیک چگالی شار مغناطیسی، برای محاسبه توان اتلافی مذکور پیشنهاد دادهاند [11].

مطالعات انجام شده بر روى مواد فرومغناطيس مختلف نشان میدهد که مقدار واقعی اتلاف توان از مجموع توان اتلافی ناشی از پسماند و جریانهای گردابهای بیشتر است. به مقدار اختلاف موجود بين اين مقادير، توان اتلافى اضافى گفته می شود که عمدتا ناشی از عیوب شبکهای و یکسان نبودن حوزههای مغناطیسی موجود در ماده، عدم نفوذ کامل شار مغناطیسی و غیریکنواخت بودن چگالی شار گذرنده از ماده است [٢٣-٢٢]. مجموع این عوامل، مدلسازی توان اتلافی اضافی را مشکل نمودهاست، با این حال تحقیقاتی بدین منظور صورت پذیرفتهاست. برتوتی بر مبنای حرکت دیوارههای حوزههای مغناطیسی، مدلی برای توان اتلافی اضافی در مواد فرومغناطیس نرم ارائه کردهاست. در این مدل، مقدار توان اضافی با توان ۲ و ۱/۵ از فرکانس و پیک چگالی شار مغناطیسی متناسب است [۲۴]. روابط تحلیلی یا تجربی مشابهی نیز برای محاسبه توان اتلافی اضافی در فریتها به دست آورده شده که نشان میدهد، مقدار توان اتلافی اضافی در این مواد با توان ۲ از فرکانس و پیک چگالی شار مغناطیسی مرتبط است [۲۵ و ۲۶]؛ همچنین مایرگویز و همكارانش بر مبناى نفوذ غيريكنواخت شار مغناطيسي، مدلى جهت محاسبه توان اتلافی اضافی ارائه دادهاند که به خوبی با نتایج تجربی مطابقت دارد [۲۷]. تنها تحقیق انجام شده بر روى افت توان اضافى در ترفنل-دى، توسط طالبيان و همکاران انجام شدهاست [۲۱]. آنها بر مبنای نفوذ غیریکنواخت شار مغناطیسی و با در نظر گرفتن دادههای تجربی حاصل از آزمایش، توان اتلافی اضافی در ترفنل-دی را

¹ Ferrite

در فرکانسها و پیکهای چگالی شار مغناطیسی مختلف مورد محاسبه قرار دادهاند.

با توجه به تحقیقات فوق، به نظر میرسد که تا کنون مدلی که شامل محدودیتهای اشارهشده از قبیل وابستگی ضرایب ساختاری ماده به شدت میدان مغناطیسی و اتلافهای توانی رخداده در فرکانسهای بالا باشد، پیشنهاد نشدهاست. در این مقاله و با ملاحظه دو عامل مذکور، یک مدل تجربی-تحلیلی جهت پیشبینی نیروی مسدود عملگر در مقادیر مختلف فرکانس و شدت میدان مغناطیسی ارائه شدهاست. در ابتدا مدل مذکور به صورت تئوری بیان شده و شدهاست. در ابتدا مدل مذکور به صورت تئوری بیان شده و یک مجموعه آزمایشگاهی به دست آورده شدهاست. با تحلیل نحوه تغییرات ضرایب ساختاری و نیز استفاده از روابط تجربی ارائه شده در مرجع [۲۱] جهت پیشبینی اتلافهای توانی در فرکانسهای بالا، مدل تجربی-تئوری نهایی معرفی شدهاست. صحت مدل مذکور نیز با مقایسه نتایج حاصل از آن با نتایج تجربی مورد ارزیابی قرار گرفتهاست.

۲- مدلسازی تئوری

به دلیل جفتشدگی مکانیکی-مغناطیسی، کرنش ترفنل-دی و شار مغناطیسی گذرنده از آن، هم بر اثر اعمال میدان مغناطیسی و هم بر اثر اعمال تنشهای مکانیکی تغییر میکنند. در حالتی که میدان مغناطیسی و تنش اعمالی فقط در راستای محور ماده باشند، کرنش و چگالی شار مغناطیسی در راستای محور ماده باشند، کرنش و چگالی شار مغناطیسی عبوری را با استفاده از روابط زیر نمایش میدهند [۲۸] : $S = s^H T + dH$ (۱) $B = dT + \mu^T H$ (۲) $B = dT + \mu^T H$ در روابط فوق *S* نشان دهنده کرنش، *T* تنش، *B* چگالی شار مغناطیسی و *H* شدت میدان مغناطیسی، *b* ضریب دگررسانی مغناطیسی، ^H تخریب انطباق الاستیکی در میدان

مغناطیسی ثابت و μ^T ضریب تراوایی مغناطیسی در تنش مکانیکی ثابت میباشد. میتوان پارامترهای T و H را بر حسب B و S به دست آورد:

 $T = \frac{1}{s^B} S - \lambda B \tag{(7)}$

$$H = -\lambda S + \nu^{s} B \tag{(f)}$$

$$I = -\frac{d}{j\omega N s^{B} \mu^{T}} (v_{2} - v_{1}) + \frac{s^{H} l_{r}}{j\omega (\mu^{T} s^{H} - d^{2}) N^{2} A_{r}}$$
(17)

 $(v_2 - v_1 = 0)$ هنگامی که عملگر در حالت کاملا بسته باشد ($v_2 - v_1 = 0$) خواهیم داشت:

$$F = \frac{d}{j\omega N s^B \mu^T} U \tag{17}$$

$$I = \frac{U}{i\omega L^S} \tag{14}$$

با ترکیب دو رابطه ۱۳ و ۱۴، به ارتباط بین نیروی مسدود عملگر و جریان اعمالی به سیمییچ تحریک می سیم:

$$F = \frac{NdA_r}{s^H l_r} I \tag{10}$$

همان گونه که در مقدمه اشاره شد، با افزایش فرکانس میدان مغناطیسی اعمالی، توان مغناطیسی منتقل شده به ترفنل-دی به علت اتلافهای رخ داده کاهش مییابد که باید در مدلسازی نیروی مسدود عملگر مورد ملاحظه قرار گیرد. اتلافهای مذکور با استفاده از روابط تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفتهاند و در نهایت روابطی تجربی شامل عبارات توانی از فرکانس و دامنه جریان الکتریکی ارائه شدهاند که امکان محاسبه توانهای اتلافی مذکور را بدون نیاز به چرخههای پسماند فراهم میکند [۲۱]. با توجه به ابعاد ترفنل-دی در عملگر مقاله حاضر، روابط توانی مذکور به صورت زیر در میآیند:

$$P_{hys} = (1.1417 \times 10^{-4}) f^{2.275} I^{1.313}$$
 (19)

$$P_{eddy} = (8.9002 \times 10^{-4}) f^{1.948} I^{0.651}$$
(19)

 $P_{excess} = (2.309 \times 10^{-3}) \times$

 $\begin{array}{l} (24)^{(2.05-0.311f^{0.1826})} \times (0.9856)^{(-0.9604f^{0.1826})} \times \\ (0.005)^{(0.9604f^{0.1826-2})} \times f^{(0.6838f^{0.1826}-0.322)} \times \\ I^{(2.05-0.311f^{0.1826})} \end{array}$

در روابط ۱۶ تا ۱۸، P_{hys} ، P_{hys} و P_{excess} به ترتیب بیانگر توان اتلافی ناشی از پسماند، جریانهای گردابهای و اضافی بر حسب وات است؛ همچنین I دامنه جریان متناوب اعمالی به سیمپیچ تحریک بر حسب آمپر و f فرکانس جریان متناوب بر حسب هرتز میباشند. هم اکنون میتوان ضریب بازده انرژی χ را به صورت زیر تعریف کرد:

$$\chi = \frac{P_{electrical} - (P_{hysteresis} + P_{eddy} + P_{excess})}{P_{electrical}}$$
(19)

Pelectrical توان الکتریکی سیمپیچ تحریک میباشد و برابر است با:

$$P_{electrical} = \frac{1}{2}ZI^{2} = \frac{1}{2}\sqrt{R^{2} + (L\omega)^{2}}I^{2}$$
 (7.)

که در این روابط s^B ضریب انطباق الاستیکی در شار مغناطیسی ثابت، h ضریب دگررسانی مغناطیسی کلاسیک و v^s ضریب رلاکتیویتی در کرنش ثابتاست و به ترتیب از روابط زیر محاسبه می شوند:

$$s^{B} = s^{H} \left(1 - \frac{d^{2}}{\mu^{T} s^{H}} \right) \tag{(a)}$$

$$\lambda = \frac{u}{\mu^T s^B} \tag{9}$$

$$v^{s} = \frac{1}{\mu^{T} \left(1 - \frac{d^{2}}{\mu^{T} s^{H}} \right)} \tag{V}$$

شکل ۱، مدار معادل الکتریکی-مکانیکی ترفنل-دی را با طول I_r مطح مقطع A_r و تعداد دور سیمپیچ N نمایش میدهد. در این شکل، U (ولتاژ دو سر سیمپیچ) و I (جریان گذرنده از سیم پیچ) به عنوان کمیتهای ورودی مدار معادل و F (نیروی ترفنل-دی) و v_1 و v_2 (سرعت نقاط ابتدایی و انتهایی ماده) به عنوان کمیتهای خروجی مدار معادل در نظر گرفته می شوند.



شکل ۱- مدار معادل الکتریکی-مکانیکی ترفنل-دی

هنگام اعمال میدان مغناطیسی متناوب با فرکانس زاویهای ۵۰، کمیتهای کرنش، چگالی شار مغناطیسی و شدت میدان مغناطیسی به ترتیب از روابط ۸ تا ۱۰ محاسبه می شوند:

$$=\frac{v_2 - v_1}{i\omega L_2} \tag{A}$$

$$B = \frac{U}{icNA}$$
(9)

S

$$H = \frac{NI}{l_r} \tag{1}$$

با جایگذاری روابط ۸ تا ۱۰ در روابط ۳ و ۴ و با توجه به این که $F = -TA_r$ که $F = -TA_r$

$$F = -\frac{A_r}{j\omega s^B l_r} (v_2 - v_1) + \frac{d}{j\omega N s^B \mu^T} U \tag{11}$$

در رابطه ۲۰، Z امپدانس ظاهری سیمپیچ، I دامنه جریان متناوب گذرنده از سیمپیچ، R مقاومت و L اندوکتانس سیم پیچ میباشد. اکنون میتوان رابطه ۱۵ را با در نظر گرفتن رابطه ۱۹ به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$F = \chi \frac{N A A_r}{s^H l_r} I \tag{(1)}$$

۳- آزمایشهای تجربی

در این مقاله از یک سوختپاش ترفنل-دی [۵]، جهت انجام آزمایشهای عملکردی استفاده شدهاست. شکل ۲ شماتیک سوختپاش مذکور و قطعات به کار رفته در آن را نمایش میدهد. میله ترفنل-دی به کار رفته در این عملگر دارای طول ۵۰ میلیمتر و قطر ۱۰ میلیمتر میباشد و سیم پیچ تحریک از ۱۲۰۰ دور سیم با قطر ۱ میلیمتر ساخته شدهاست. سیم پیچ تحریک توانایی عبور ۷ آمپر جریان را دارد تا انجام آزمایشهای مختلف در مقادیر مختلف شدت میدان مغناطیسی (از صفر تا اشباع) ممکن باشد. همچنین برای بهینه سازی رفتار مغناطیسی-مکانیکی ترفنل-دی از پیچ پیشبار جهت اعمال پیشتنش مکانیکی استفاده شدهاست.



برای بررسی رفتار نیرو-جابجایی عملگر ترفنل-دی باید مجموعهای به کار گرفته شود که امکان آزمایش در مقادیر مختلف شدت میدان مغناطیسی و تنش مکانیکی را فراهم کند. علاوه بر این، مجموعه ساختهشده باید دارای حسگرهایی باشد که بتواند به صورت همزمان نیروی وارد بر ترفنل-دی و تغییر طول آن را اندازه گیری نماید. با توجه به ملاحظات فوق، از دستگاه تست کشش مطابق شکل ۳، جهت

انجام آزمایشها استفاده شدهاست. این مجموعه آزمایشگاهی دارای اجزای زیر است:

 ۱- دستگاه تست کشش و نیروسنج موجود در آن: به منظور اعمال تنش بر عملگر مورد استفاده قرار می گیرد.

۲- عملگر ترفنل-دی: از سوخت پاش نشان دادهشده در شکل ۲، استفاده شدهاست.

۳- منبع تغذیه جریان مستقیم: جهت عبور جریان از سیم پیچ تحریک عملگر و ایجاد میدان مغناطیسی به کار گرفته شدهاست.

۴- کرنش سنج طولی چسبیده به ترفنل-دی به همراه دیتا لاگر مربوطه (مدل DC-97A محصول شرکت TML): برای اندازه گیری کرنش ایجاد شده در ترفنل-دی به هنگام اعمال میدان مغناطیسی و تنش مکانیکی استفاده شده است.

۵- کارت A/D: به منظور تبدیل دادههای آنالوگ دیتا لاگر کرنش سنج و نیروسنج به دادههای دیجیتال و ارسال به رایانه استفاده شده است.

۶- رایانه: به منظور ذخیرهسازی دادههای دیجیتال، کاهش نرم افزاری نویز و تبدیل دادههای خام به کمیتهای هدف استفاده می شود.



شکل ۳- مجموعه آزمایشگاهی شامل دستگاه تست کشش و سوختپاش ترفنل-دی

در هر آزمایش با استفاده از منبع تغذیه، یک جریان مشخص به سیمپیچ تحریک عملگر اعمال میشود که موجب ایجاد یک میدان مغناطیسی ثابت میشود. این میدان

مغناطیسی باعث افزایش طول ترفنل-دی میشود و افزایش طول، توسط کرنشسنج طولی متصل به ترفنل-دی اندازهگیری میشود. سپس کلگی دستگاه کشش به حرکت در آمده و در مدت زمان مشخصی نیروی وارده به عملگر از صفر تا مقدار نهایی افزایش مییابد. در حین افزایش نیروی فشاری وارده به عملگر، طول ترفنل-دی کاهش مییابد. با ذخیره همزمان مقدار نیرو (اندازهگیری شده توسط نیروسنج دستگاه کشش) و تغییر طول ترفنل-دی (اندازهگیری شده توسط کرنشسنج) میتوان رفتار تنش-کرنش عملگر ترفنل-دی را به دست آورد.

شکل ۴ تنش-کرنش عملگر مورد استفاده را در مقادیر مختلف میدان مغناطیسی نشان میدهد. در هر مقدار از شدت میدان مغناطیسی، ابتدا نیرویی به عملگر وارد نمی شود و در نتیجه عملگر دارای بیشترین مقدار کرنش در آن شدت میدان مغناطیسی است. با افزایش تنش فشاری بر روی عملگر و بالطبع میله ترفنل-دی، کرنش آن کاهش می ابد و در یک مقدار از تنش اعمالی، به صفر می رسد که همان تنش مسدود است. تنش مسدود، بیشترین مقدار تنشی است که عملگر ترفنل-دی در هر مقدار از شدت میدان مغناطیسی قادر به ایجاد آن است. به عبارت دیگر در این نقطه از نمودارها، سختی عوامل محصور کننده عملگر به بی نهایت رسیده و کرنش ترفنل-دی صفر می شود.



محل ۱- رفتار نیش-درنس عملکر ترفیل-دی در مقادیر مختلف شدت میدان مغناطیسی

همان گونه که از شکل ۴ برمی آید، در هر مقدار از شدت میدان مغناطیسی، رابطه تنش و کرنش عملگر خطی نیست.

غیر خطی بودن این رابطه از آنجا ناشی میشود که ضریب دگررسانی مغناطیسی و همچنین ضریب انطباق الاستیکی ترفنل-دی ثابت نبوده و تابع شدت میدان مغناطیسی و تنش اعمالی است.

شکل ۵ تنش مسدود عملگر ترفنل-دی را در مقادیر مختلف شدت میدان مغناطیسی نشان میدهد. نحوه افزایش این کمیت نیز با شدت میدان مغناطیسی خطی نیست. غیرخطی بودن به دلیل ثابت نبودن مقادیر ضریب دگررسانی مغناطیسی و انطباق الاستیکی و نیز وابستگی تراوایی مغناطیسی به شدت میدان مغناطیسی میباشد. با تغییر مقدار تراوایی مغناطیسی، سطح مغناطیس شوندگی ترفنل-دی نیز تغییر میکند و موجب غیر خطی شدن کرنش و تنش می شود.



۴- نتایج و صحت سنجی

در قسمت قبل تنش مسدود عملگر ترفنل-دی در مقادیر مختلف شدت میدان مغناطیسی به دست آورده شد. با توجه به رابطه ۱ و از آنجا که در تنش مسدود، کرنش ماده برابر صفراست، میتوان نوشت:

$$\frac{d}{s^H} = -\frac{T}{H} \tag{(11)}$$

بنابراین نسبت ضریب دگررسانی مغناطیسی به ضریب انطباق الاستیکی را میتوان از روی نتایج تجربی به دست آورد. شکل ۶ نسبت مذکور را در مقادیر مختلف میدان مغناطیسی نمایش میدهد.



با افزایش شدت میدان مغناطیسی، نسبت ضریب دگررسانی مغناطیسی به ضریب انطباق الاستیکی در تنش مسدود کاهش مییابد. به منظور پیش بینی مقدار نسبت فوق در هر مقدار دلخواه از میدان مغناطیسی، یک خط بر مبنای کمینهسازی مجموع مربعات خطاها به دست آورده شده که در شکل ۶ نشان داده شدهاست. معادله خط عبار تست از: $\frac{d}{sH} = -0.01941H + 3190$ (۲۳) با توجه به این که R-Square خط مذکور ۳۹۶۶۳ می باشد، برازش انجام شده از دقت مطلوبی برخوردار است. با جایگذاری رابطه ۱۰ در رابطه ۲۳ خواهیم داشت: (۲۴) (۲۴) (۲۴) ۲۱ می توان دامنه جریان متناوب گذرنده از سیم پیچ را جهت می توان دامنه جریان متناوب گذرنده از سیم پیچ را جهت

ایجاد نیروی مسدود مورد نظر در هر فرکانس محاسبه نمود. شکل ۷ مقادیر به دست آمده برای دامنه جریان الکتریکی را به منظور ایجاد چهار مقدار از نیروی مسدود در هشت فرکانس مختلف نشان میدهد.

برای اطمینان از صحت مقادیر به دست آمده، دامنه جریان لازم برای ایجاد نیروی مسدود مورد نظر در هر فرکانس به صورت تجربی هم به دست آمدهاست. بدین منظور از مجموعه آزمایشگاهی قسمت قبلی (شکل ۳) استفاده شدهاست. روند کار بدین صورت بودهاست که ابتدا، عملگر ترفنل-دی روی دستگاه کشش قرار گرفته، سپس

کلگی دستگاه به سمت پایین حرکت کرده تا نیروی مسدود مشخصی را به عملگر وارد نماید (نیروی وارد شده توسط نیرو سنج دستگاه اندازه گیری میشود). در اینصورت ترفنل-دی تحت تنش فشاری قرار گرفته و دارای کرنش منفی خواهد بود که توسط کرنش سنجاندازه گیری شده و در اسیلوسکوپ نشان داده میشود. سپس با استفاده از منبع تغذیه جریان متناوب، جریان مشخصی در فرکانس مورد آزمایش به سیم پیچ تحریک اعمال میشود، به نحوی که حداکثر کرنشاندازه گیری شده توسط کرنش سنج متصل به ترفنل-دی برابر با لازم برای ایجاد نیروی مسدود مورد نظر میباشد. شکلهای لازم برای ایجاد نیروی مسدود مورد نظر میباشد. شکلهای ۸ تا ۱۱، مقادیر کرنش نشان داده شده توسط اسیلوسکوپ را بعد از اعمال جریان متناوب، در چند فرکانس مختلف نشان میدهد.



شکل ۷- دامنه جریان الکتریکی لازم برای ایجاد نیروهای مسدود مشخص در فرکانسهای مختلف





شکل ۱۲ مقادیر به دست آمده برای دامنه جریان متناوب در آزمایشهای فوق را در مقایسه با نتایج حاصل از مدلسازی نشان میدهد.



شکل ۱۲- مقادیر تجربی (خط چین) و تئوری (پیوسته) به دست آمده برای دامنه جریان الکتریکی سیم پیچ تحریک به منظور ایجاد نیروی مسدود مشخص

میانگین خطای مقادیر محاسبه شده برای دامنه جریان در مقایسه با مقادیر تجربی به ازای چند مقدار مختلف نیروی مسدود در جدول ۱ آمدهاست. با توجه به جدول ۱ مشاهده میشود که مدل به دست آمده دارای کمترین مقدار خطا (۱/۶/) در پیشبینی دامنه جریان برای ایجاد نیروی ۲۵۰۰ نیوتن و بیشترین مقدار خطا (۸/٪۵) در پیشبینی دامنه جریان برای ایجاد نیروی ۹۰۰۰ نیوتن میباشد.

جدول ۱- میانگین خطای مقادیر محاسبه شده برای دامنه جریان در مقایسه با مقادیر تجربی به ازای مقادیر مختلف نیروی مسدود

		-		
٩٠٠٠	۷۵۰۰	۵۰۰۰	۲۵۰۰	نیروی مسدود (نیوتن)
۵/۸	Δ/V	١/٩	۱/۶	میانگین خطای مدل نسبت به آزمایش (./)

همچنین میانگین خطای مقادیر محاسبه شده برای دامنه جریان در مقایسه با مقادیر تجربی در فرکانسهای مختلف در جدول ۲ آمدهاست. با توجه به جدول ۲، مدل ارائه شده در فرکانس ۱۰۰ هرتز دارای کمترین خطا (۵//۲) و در فرکانس ۵۰ هرتز دارای بیشترین خطا (۵//۲) است. با توجه به این که فرکانسهای ۲۵۰، ۲۵۰ و ۴۰۰ هرتز خارج از محدوده آزمایشهای اولیه برای به دست آوردن مقادیر اتلاف توان

میباشند [۲۱]، مقدار خطا در این فرکانسها نسبت به فرکانسهای کوچکتر افزایش یافتهاست.

جدول ۲- میانگین خطای مقادیر محاسبه شده برای دامنه جریان سیمپیچ تحریک در مقایسه با مقادیر تجربی در

فركانسهاي مختلف

4	۳۰۰	۲۵۰	۲۰۰	10.	١٠٠	۵۰	فرکانس (هرتز)
۶/۵	c/r	۵	۴/۲	٣/٢	۲/۵	۲/۵	خطا
	711						(درصد)

اختلاف میان نتایج مدلسازی با نتایج تجربی را می توان ناشی از دو عامل اصلی دانست: عامل اول به ماهیت روابط تجربی ۱۹ و ۲۴ بر می گردد، چرا که این روابط از برازش بر روی نتایج تجربی به دست آمدهاند و دارای خطای ذاتی هستند. عامل دوم مربوط به ماهیت غیر خطی رفتار ترفنل-دی است که با افزایش فرکانس نمود بیشتری می یابد و بالطبع خطای مدل تجربی را افزایش می دهد. با این حال به نظر می رسد که مدل ارائه شده دارای دقت مناسبی در پیش بینی میدان مغناطیسی لازم برای ایجاد نیروی مسدود دلخواه در دامنه فرکانسی ۰-۴۰۰ هرتز باشد.

۵- نتیجه گیری

در این مقاله، یک مدل بهبودیافته بر اساس ترکیب مدل مکانیکی-مغناطیسی خطی و ضریب بازده انرژی ارائه شد که امکان محاسبه و پیش بینی نیروی مسدود عملگر ترفنل-دی را فراهم می کند. در ابتدا و به منظوراستخراج ضرایب عملکردی ماده، یک مجموعه آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت و منحنیهای تنش-کرنش عملگر در هنگام اعمال میدان مغناطیسی مستقیم به دست آورده شدند. نحوه مناسب تخمین زده شد تا امکان برآورد ضرایب مذکور در هر مقدار دلخواه از شدت میدان مغناطیسی فراهم شود. سپس و به منظور توسعه مدل در هنگام اعمال جریان مغناطیسی متناوب، ضریب بازده انرژی عملگر تعریف شد که شامل تمام اتلافهای رخ داده در انرژی مغناطیسی است. با توجه به نتایج حاصل، میتوان دریافت که:

۱- مزیت اصلی مدل پیشنهادی این است که برای محاسبه نیروی خروجی عملگر تنها از دو متغیر ورودی شامل شدت و فرکانس جریان الکتریکی استفاده میکند و نیازی به نمودارهای پسماند مغناطیسی ماده ندارد. این موضوع از آنجا حائز اهمیتاست کهاستخراج این نمودارها علی الخصوص در کاربردهای صنعتی و عملی در فرکانسهای بالا نیاز به آزمایشهای متعدد و تجهیزات اندازه گیری خاصی دارد که لزوما در دسترس نیستند.

۲- مقایسه نتایج حاصل از این مدل با نتایج تجربی نشاندهنده آن است که مدل مذکور علاوه بر سهولت درکاربرد، از دقت مناسبی نیز برخوردار است، به نحوی که میانگین خطای اندازه گیری شده بین نتایج مدل و نتایج تجربی در هفت فرکانس مختلف، ۵٪ به دست آمدهاست.

۳- مدل پیشنهادی قابلیت پیش بینی نیروی مسدود را برای هر نمونه ترفنل-دی با طول و سطح مقطع دلخواه دارد، چرا که روابط تجربی استفاده شده از تحلیل تنش-کرنش ماده استخراج شدهاند و برای همه عملگرهایی که بر مبنای تحریک طولی ماده طراحی و ساخته می شوند، معتبر می با شند.

مراجع

- Kellogg R, Flatau A (1999) Blocked force investigation of a Terfenol-D transducer. Proc. SPIE's 6th Annual International Symposium on Smart Structure and Materials, Newport Beach, CA, United States.
- [2] Bhattocharya B (2005) Terfenol and Galfenol smart magnetostrictive metals for intelligent transducer. J. Ind. Inst Tech Kanpur 7: 33 41.
- [3] Goodfriend M, Shoop K (1992) Adaptive characteristics of the magnetostrictive alloy, Terfenol-D, for active vibration control. J. Intell. Mater. Sys. Stru. 3: 245–54.
- [4] Karunanidhi S, Singaperumal M (2010) Design, analysis and simulation of magnetostrictive actuator and its application to high dynamic servo valve. Sen. Act. A: Phys. 157(2): 185-197.
- [5] Ghodsi M, Hosseinzadeh N, Özer A, Rajabzadeh Dizaj H, Garjasi Varzeghani N (2017) Development of Gasoline Direct Injector Using Giant Magnetostrictive Materials. IEEE Trans. Ind. App. 53(1): 521-529.

D Magnetostrictive Material. IEEE Trans. Mags. 54: 1-4.

- [17] Talebian S (2018) Theoretical and experimental study on magnetic hysteresis loss of Terfenol-D. Proc. ISME2018, Iran, Tehran.
- [18] Goodenough J (2002) Summary of Losses in Magnetic Materials. IEEE Trans. Mags, 38: 234-240.
- [19] Bozorth R (2003) Ferromagnetism. IEEE Press.
- [20] Yan R, Yang Q, Yang W, Hou S, Yan W (2010) Dynamic Model of Giant Magnetostrictive Acceleration Sensors Including Eddy-Current Effects. IEEE Trans. App. Supercond. 20(3): 1874-1877.
- [21] Talebian S, Hojjat Y, Ghodsi M, Karafi M R (2015) Study on classical and excess eddy currents losses of Terfenol-D. J. Mag. Magc. Mates. 388: 150–159.
- [22] Overshott K J (2012) The use of domain observations in understanding and improving the magnetic properties of transformer steels. IEEE Trans. Mags. 12: 840-846.
- [23] Overshott K J (1981) The Causes of the Anomalous Loss in Amorphous Ribbon Materials. IEEE Trans. Mags. 17(6): 341-347.
- [24] Bertotti G (1988) General Properties of Power Losses in Soft Ferromagnetic Materials. IEEE Trans. Mags. 24(1): 621-630.
- [25] Tenant P, Rousseau J J (1998) Dynamic model of magnetic materials applied on soft ferrites. IEEE Trans. Pow. Elects. 13(2): 372–9.
- [26] Mayergoyz I D, Serpico C (2000) Frequency scaling of excess hysteresis loss. IEEE Trans. Mags 36(5): 3192–3194.
- [27] Serpico C, Visone C, Mayergoyz I D, Basso V, Miano G (2000) Eddy current losses in ferromagnetic laminations. J. App. Phys. 87(9): 6923-6925.
- [28] Engdahl G (2000) Handbook of Giant Magnetostrictive Materials. Royal Institute of Technology Press, Stockholm, Sweden.

- [6] Olabi A G, Grunwald A (2008) Design and application of magnetostrictive materials, J. Mats. Des. 29(2): 469-483.
- [7] Claeyssen F, Lhermet N, Maillard T (2003) Magnetostrictive actuators compared to piezoelectric actuators, Proc. SPIE 4763, European Workshop on Smart Structures in Engineering and Technology, Giens, France, March.
- [8] Honda T, Hayashi Y, Yamaguchi M, Arai K I (1994) Fabrication of thin-film actuators using magnetostriction. IEEE Trans. J. Mag. 9: 27-32.
- [9] Tan X, Baras J S (2004) Modeling and control of hysteresis in magnetostrictive actuators. Automatica 40(9): 1469-1480.
- [10] Sun L, Zheng X (2006) Numerical simulation on coupling behavior of Terfenol-D rods. Int. J. Sol. Struc. 43(6): 1613-1623.
- [11] Dapino M J, Flatau A B, Calkins F T (2006) Statistical Analysis of Terfenol-D Material Properties. J. Intell. Mater. Sys. Stru. 17: 587-599.
- [12] Zhang D, Li M, Zhoua H (2015) A general onedimension nonlinear magneto-elastic coupled constitutive model for magnetostrictive materials. AIP Adv. 5 (10).
- [13] Domenjoud M, Berthelot E, Galopin N, Corcolle R, Bernard Y, Daniel L (2009) Characterization of giant magnetostrictive materials under static stress: influence of loading boundary conditions. Smart Mats. Stru. 28(9).
- [14] Yamamoto K, Nakano H, Yamashiro Y (2003) Effect of compressive stress on hysteresis loss of Terfenol-D. J. Magn. Magc. Mats. 254: 222–224.
- [15] Jianbin Z, Haiquan Z, Baodong B, Ming Y (2009) Calculation of hysteresis losses for Terfenol-D ultrasonic transducer. Proc. Second International Conference on Smart Materials and Nanotechnology in Engineering, Weihai, China.
- [16] Huang W, Gao C, Li Y, Wang B (2018) Experimental and Calculating Analysis of High-Frequency Magnetic Energy Losses for Terfenol-